

Наборы диодов, предназначенные для конструирования вторичных источников питания. Микросхемы конструктивно оформлены в корпусе типа 402.16-7

### 542НД1, К542НД1

Микросхемы представляют собой диодный мост

### 542НД2, К542НД2

Микросхемы используются в качестве диодных матриц из четырех диодов с общим катодом.

### 542НД3, К542НД3

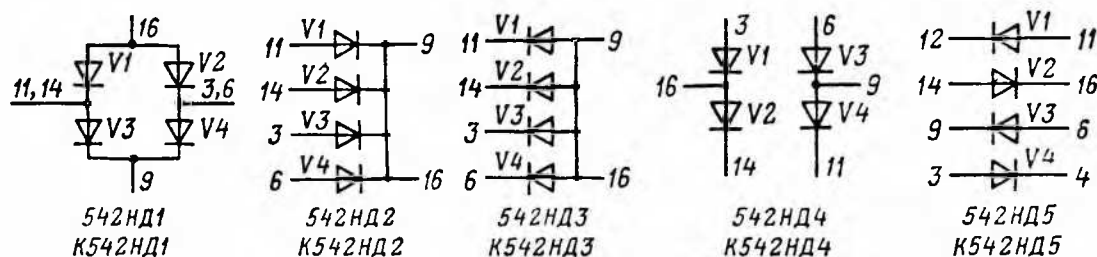
Микросхемы применяются как диодные матрицы из четырех диодов с общим анодом.

### 542НД4, К542НД4

Микросхемы представляют собой как бы две пары последовательно включенных диодов.

### 542НД5, К542НД5

Микросхемы представляют собой четыре изолированных диода.



Схемы подключения диодов в ИМС серий 542, К542

Параметры <sup>1</sup>	Режим измерения	Значения
$I_{пр\ ср}$ , В	$I_{пр\ ср\ max} = 500$ мА	$\leq 1,2$
$I_{обр\ ср}$ , мкА	$U_{обр\ и\ max} = 50$ В	$\leq 100$
$U_{и\ обр\ max}$ , В	$f \leq 100$ кГц; $T = -60... + 125$ °С	50
$I_{пр\ ср\ max}$ , мА	$f \leq 50$ Гц, $T = -60... + 55$ °С	500
$I_{пр\ и\ max}$ , мА	$t_{и1} = 1$ с	$3I_{пр\ ср\ max}$
	$t_{и2} = 0,5$ с	$10I_{пр\ ср\ max}$
$f_{ма}$ , кГц		100
$R_{из}^2$ , МОм	$U = 50$ В	$\geq 5$

<sup>1</sup> При температуре  $25 \pm 10$  °С.

<sup>2</sup> Сопротивление изоляции между корпусом и выводами или между выводами при постоянном напряжении 50 В.

Примечание. Значения параметров указаны для одного диода при условии, что остальные три диода находятся в нерабочем состоянии.